

2026

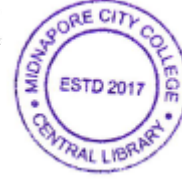
6th Semester Examination (CCFUP : NEP)

PHYSICS

Paper : MI 6-T

(Minor)

[Analog Electronics]



Full Marks : 40

Time : Two Hours

*The figures in the margin indicate full marks.
Candidates are required to give their answers
in their own words as far as practicable.*

Group - A

Answer any *five* questions : $2 \times 5 = 10$

1. Define Drift velocity. Why does Drift velocity increase with electric field only up to a certain limit? 1+1
2. State two differences between LED and ordinary diode. 1+1
3. What is Zener breakdown? Mention its significance. 1+1
4. Define current gains α and β , and establish the relation between them. 1+1
5. Why is the width of the collector largest compared to base and emitter in a transistor? P.T.O.

(2)

6. Analyze the effect of forward bias and reverse bias on the barrier potential of a p-n junction diode.
7. What is the Q-point (operating point) of a transistor?
8. Define the Common Mode Rejection Ratio (CMRR) and the slew rate of an operational amplifier.

Group - B

Answer any *four* questions : $5 \times 4 = 20$

9. Using the concept of Energy Level Diagram, explain the difference between intrinsic and extrinsic semiconductors.
10. A full-wave rectifier supplies 50 Hz input with peak voltage 40 V and load resistance $2\text{ k}\Omega$. Calculate DC output voltage, current, and efficiency. $2+2+1$
11. Explain the formation of p-type and n-type semiconductors with energy band diagrams.
12. Describe the V-I characteristics of a p-n junction diode under both forward and reverse bias with suitable diagram.
13. In a common-emitter (CE) circuit, the following parameters are given :

$$V_{CC} = 12\text{V}, R_C = 2\text{ k}\Omega, \beta = 100, I_B = 20\mu\text{A}.$$

Find :

- (i) The collector current, I_C



(3)

- (ii) The collector-emitter voltage, V_{CE}
- (iii) The region of operation of the transistor
14. Explain the working of an Op-Amp adder circuit with diagram and find the equation for output voltage.

Group - C

Answer any *one* question : $10 \times 1 = 10$

15. (a) Discuss barrier potential and depletion layer width in an p-n junction. How do they depend on doping concentration?
- (b) Explain the working of a capacitor filter in a rectifier circuit. How does it reduce ripple in the output? $5+5$
16. Using h -parameter model, derive expressions for input impedance, output impedance, and voltage gain of a CE amplifier. $2+3+3+2$

বঙ্গানুবাদ

বিভাগ - ক

যে-কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও : $2 \times 5 = 10$

- ১। Drift velocity কী? কেন Drift velocity শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র বৃদ্ধির সাথে বৃদ্ধি পায়? $5+5$
- ২। LED এবং সাধারণ ডায়োডের মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখো।

P.T.O.



(4)

- ৩। Zener breakdown কি? এর সূত্র কী? ১+১
- ৪। Current gain α এবং β কী? তাদের সম্পর্ক স্থাপন করো। ১+১
- ৫। একটি ট্রানজিস্টরের collector region কেন সবচেয়ে বড়ো হয় base এবং emitter-এর তুলনায়?
- ৬। ফরোয়ার্ড বায়াস এবং রিভার্স বায়াস অবস্থায় একটি p-n জংশন ডায়োডের ব্যারিয়ার পোটেনশিয়ালের উপর প্রভাব বিশ্লেষণ করো।
- ৭। ট্রানজিস্টরের Q-point (অপারেটিং পয়েন্ট) কী?
- ৮। একটি অপারেশনাল অ্যামপ্লিফায়ারের CMRR (Common Mode Rejection Ratio) এবং স্লিউ রেট (slew rate)-এর সংজ্ঞা দাও।

বিভাগ - খ

যে-কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও : $৫ \times ৪ = ২০$

- ৯। Energy Level Diagram-এর ধারণা ব্যবহার করে intrinsic এবং extrinsic সেমিকন্ডাক্টরের মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করো।
- ১০। একটি full-wave rectifier-এ 50 Hz ইনপুট এবং 40 V পিক ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হয়েছে, এবং লোড রেজিস্ট্যান্স $2 k\Omega$ । DC আউটপুট ভোল্টেজ, কারেন্ট এবং দক্ষতা (efficiency) নির্ণয় করো। ২+২+১
- ১১। এনার্জি ব্যান্ড ডায়াগ্রামের সাহায্যে p-type এবং n-type সেমিকন্ডাক্টরের গঠন ব্যাখ্যা করো।

(5)

- ১২। একটি p-n জংশন ডায়োডের ফরোয়ার্ড ও রিভার্স বায়াস অবস্থায় V-I বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করো এবং উপযুক্ত চিত্র অঙ্কন করো।
- ১৩। একটি কমন-এমিটার (CE) বর্তনীতে নিম্নলিখিত মানগুলি দেওয়া আছে :
 $V_{CC} = 12V$, $R_C = 2k\Omega$, $\beta = 100$, $I_B = 20\mu A$.
 নির্ণয় করো :
 (i) কালেক্টর কারেন্ট, I_C
 (ii) কালেক্টর-এমিটার ভোল্টেজ, V_{CE}
 (iii) ট্রানজিস্টরের কার্যকারী অঞ্চল
- ১৪। একটি Op-Amp অ্যাম্পার বর্তনীর কার্যপ্রণালী উপযুক্ত বর্তনী চিত্রসহ ব্যাখ্যা করো এবং আউটপুট ভোল্টেজের জন্য সমীকরণ নির্ণয় করো।

বিভাগ - গ

যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও : $১০ \times ১ = ১০$

- ১৫। (ক) p-n জংশনে ব্যারিয়ার পোটেনশিয়াল (barrier potential) এবং ডিপ্লিশন লেয়ারের প্রস্থ (depletion layer width) আলোচনা করো। এগুলি ডোপিং ঘনত্ব (doping concentration)-এর উপর কীভাবে নির্ভর করে?

(খ) একটি রেষ্টিফায়ার বর্তনীতে ক্যাপাসিটর ফিল্টারের কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা করো। এটি কীভাবে আউটপুটের রিপল (ripple) কমায়? ৫+৫

১৬। h -parameter মডেল ব্যবহার করে একটি CE (Common Emitter)-এর input impedance, output impedance এবং voltage gain-এর গাণিতিক রাশি নির্ণয় করো। ২+৩+৩+২

